

НОВАЯ РАЗРАБОТКА



## ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СЛОЕВ С ICP ИСТОЧНИКОМ ПЛАЗМЫ СО ШЛЮЗОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ ИЗ КАСЕТЫ В КАСЕТУ ИЗОФАЗ ТМ 200-02К

(ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ С ЗАГРУЗКОЙ ОДНОЙ ПЛАСТИНЫ ЧЕРЕЗ ШЛЮЗ ИЗОФАЗ ТМ 200-02)

**Назначение:** Формирование щелевой изоляции заполнением отверстий диэлектриком, межслойной изоляции осаждением диэлектрика на металлические шины и заполнение зазоров между ними, изолирующего слоя ( $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Si}_3\text{N}_4$ ) на стенках контактных и переходных отверстий межслойных соединений и др.



### Особенности:

- Индивидуальная обработка пластин на рабочем столе:  $\varnothing$  76, 100, 150, 200мм – 1 шт.;
- В модификации ИЗОФАЗ ТМ 200-02 возможна групповая обработка подложек 60x48мм и пластин  $\varnothing$  76мм на носителе;
- Транспортная система переноса пластин из шлюзовой камеры в реактор на основе манипулятора;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки пластин в кассете;
- Источник ICP плазмы с плоским индуктором;
- Нагреваемый ВЧ рабочий стол с поддержанием температуры +40...+300°C, подачей гелия под пластину и прижимом;
- Скорость осаждения диэлектрических слоев, не менее 20 нм/сек;
- Максимальное аспектное отношение, 3...5;
- Система прогрева стенок реактора до +80°C;
- Безмасляная система откачки.

